



深圳市明微电子股份有限公司

SHENZHEN SUNMOON MICROELETRONICS CO.,LTD

地址：深圳市高新技术产业园南区高新南一道国微大厦 5 楼

ADD: Shenzhen High-tech Industrial Park, South Area Gaoxin S. Ave. 1st, Guowei Building.

电话 Tel: 0755-26991391

传真 Fax: 0755-26991336

邮编: 518057

网址: www.chinaasic.com

电子邮箱 Email: sunmoon@ssmec.com

SM74HC595D

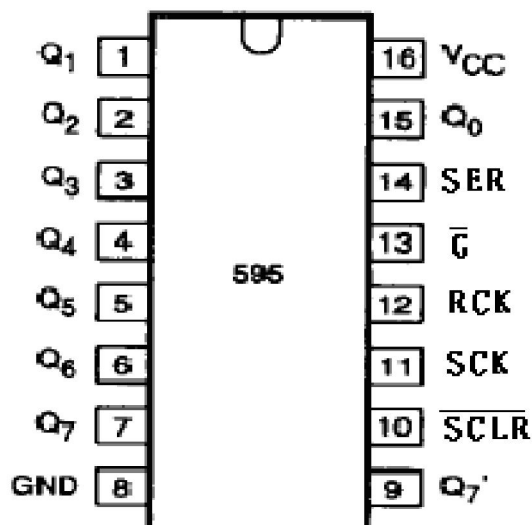
一、简述

SM74HC595D 是一种具有 8 位锁存、8 位串行输入、8 位串/并行输出、串—并移位寄存器和三态输出功能的通用 LED 驱动芯片。具有 8 位移位寄存器和一个存储器，三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在 SCK 的上升沿输入，在 RCK 的上升沿进入的存储寄存器中去。移位寄存器有一个串行移位输入 (SER)，和一个串行输出 (Q7')，和一个异步的低电平复位，存储寄存器有一个并行 8 位的，具备三态的总线输出，当使能时 \bar{G} (为低电平)，存储寄存器的数据输出到总线。它可以与其他公司生产的 74HC595 完全兼容。

二、功能特点：

- 具有 8 位串行输入；
- 具有 8 位串行和并行输出；
- 具有移位寄存器直接清“零”功能；
- 具有锁存与 3 态输出功能；
- 能通过 50MHz 移位时钟；
- 工作电压：2V—6V

三、脚位图



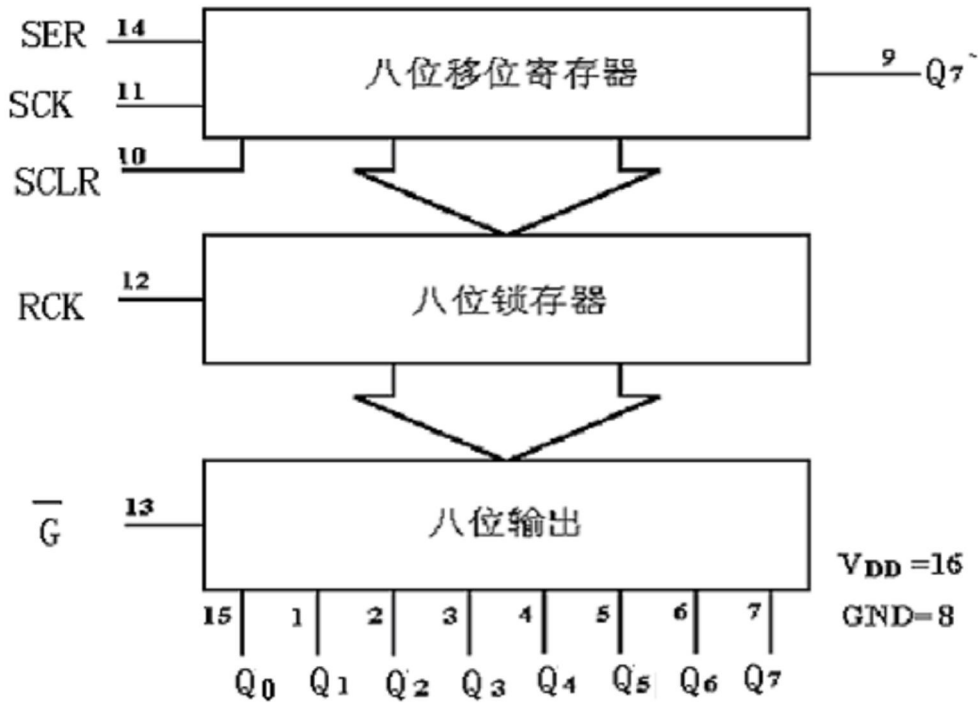
四、管脚功能定义

管脚序号	符号	管脚功能
10	$\overline{\text{SCLR}}$	复位端
11	SCK	移位寄存器时钟，上升沿移位
12	RCK	锁存寄存器时钟，上升沿存储
13	$\overline{\text{G}}$	输出使能端，为低电平使，输出选通；为高电平时，输出为 3 态
14	SER	串行数据输入端
15、1--7	Q0---Q7	并行输出端
9	Q7'	串行输出
8	GND	逻辑地
16	V _{CC}	电源端

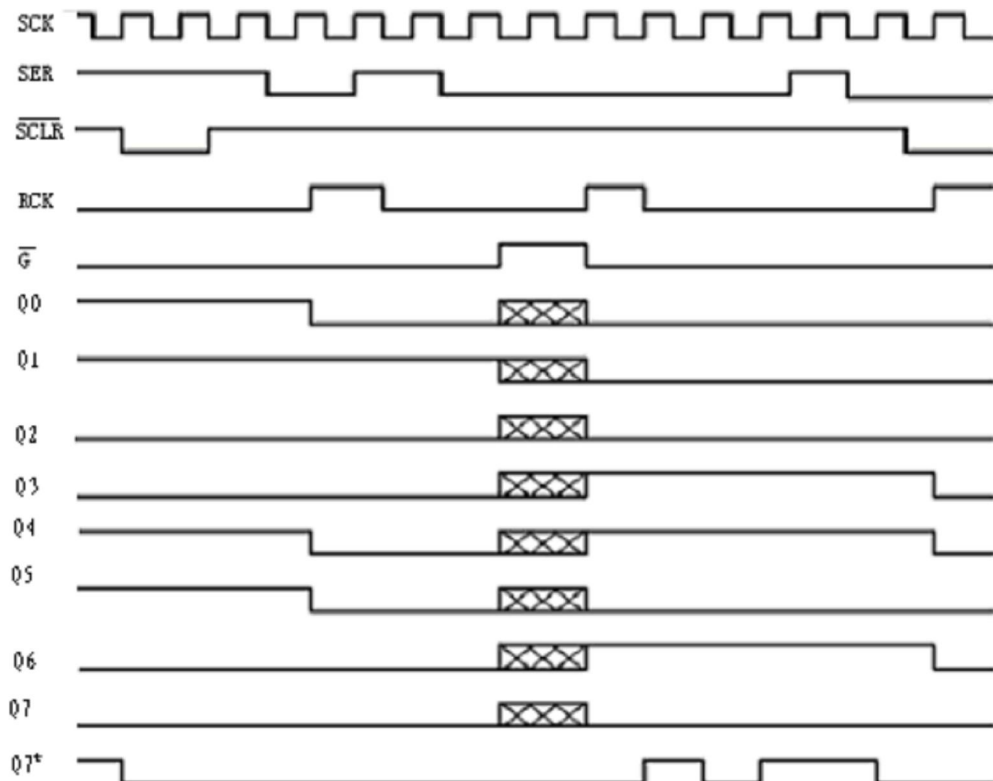
五、功能真值表

RCK	SCK	$\overline{\text{SCLR}}$	$\overline{\text{G}}$	功能
X	X	X	H	Q0---Q7 为 3 态、
X	X	L	L	移位寄存器清“零”，Q7'=0
X	↑	H	L	移位寄存器存储，Q _N =Q _{N-1} ，Q _A =SER
↑	X	H	L	存储移位寄存器的值

六、逻辑框图



七、工作时序图



八、直流电气特性

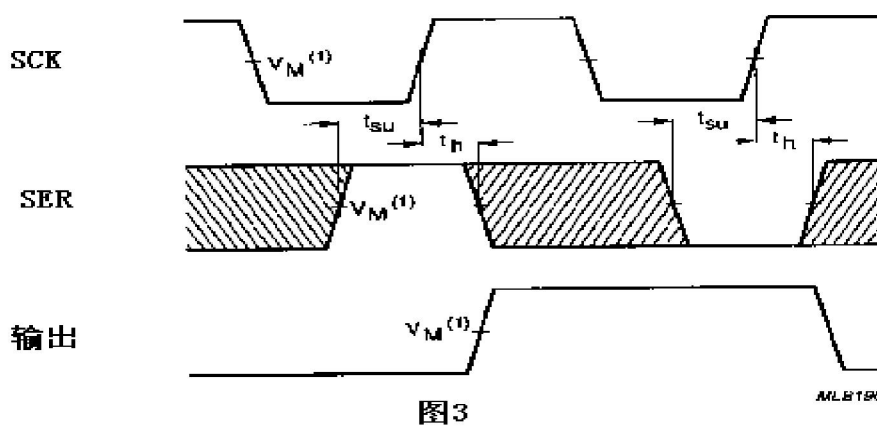
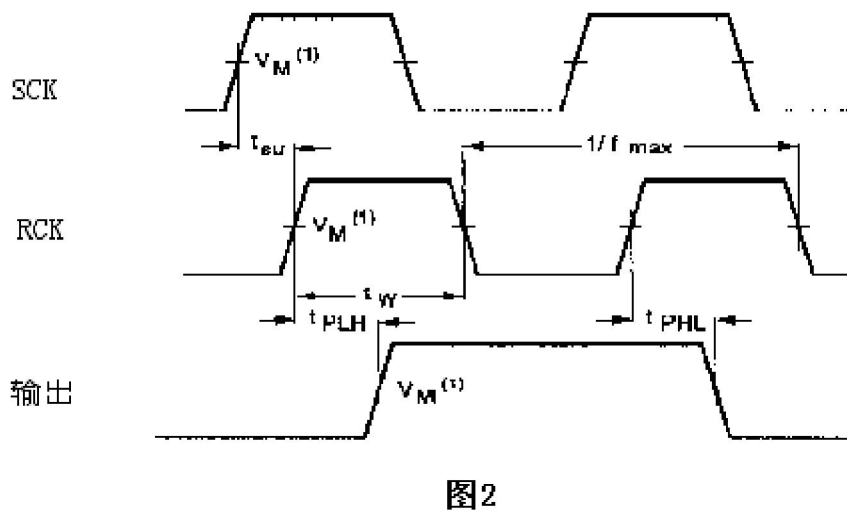
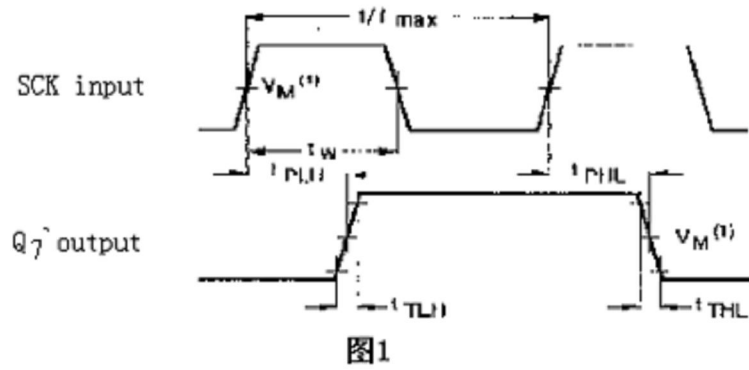
符号	参数	条件	VCC	T=25 ⁰	单位				
				典型值					
V _{IH}	输入高电平最低电压		2.0V	1.5	V				
			4.5V	3.15					
			6.0V	4.2					
V _{IL}	输入低电平最高电压		2.0V	0.5	V				
			4.5V	1.35					
			6.0V	1.8					
V _{OH}	输出高电平最小值	V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤20 uA	2.0V	1.9	V				
			4.5V	4.4					
			6.0V	5.9					
Q7'	Q7'	V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤4.0 mA I _{OUT} ≤5.2 mA	4.5V	3.84	V				
			6.0V	5.34					
			Q0----Q7	4.5V		3.84			
Q0----Q7	Q0----Q7	V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤6.0 mA I _{OUT} ≤8.2 mA	6.0V	5.34	V				
			V _{OL}	输出低电平最大值		V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤20 uA	2.0V	0.1	V
							4.5V	0.1	
6.0V	0.1								
Q7'	Q7'	V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤4.0 mA I _{OUT} ≤5.2 mA	4.5V	0.33	V				
			6.0V	0.33					
			Q0----Q7	4.5V		0.33			
Q0----Q7	Q0----Q7	V _{IV} =V _{IH} or V _{IL} I _{OUT} ≤6.0 mA I _{OUT} ≤7.8 mA	6.0V	0.33	V				
			I _{IN}	最大输入电流		V _{IN} =VCC or GND	6.0V	±1.0	uA
			I _{OZ}	最大 3 态输出漏电流		V _{out} =VCC or GND G=V _{IH}	6.0V	±5.0	uA
I _{CC}	最大静态电流	V _{out} =VCC or GND I _{OUT} =0 uA	6.0V	80	uA				

九、交流电气特性

GND=0, T_r=T_f=6ns, C_L=50 PF VCC=4.5V

符号	参数	T 温度			单位	波形图
		+25 ⁰				
		最小	典型	最大		
t _{PHL} /t _{PLH}	移位时钟有效沿到 Q7' 输出的延迟	—	15	22	ns	图 1
t _{PHL} /t _{PLH}	存储时钟有效沿到输出的延迟	—	16	22		图 2
t _{PHL}	复位有效沿到 Q7' 输出的延迟	—	20	40		图 4
t _{PZH} /t _{PZL}	3 态允许信号有效沿到输出的时间	—	21	35		图 5
t _{PZH} /t _{PZL}	3 态禁止信号有效沿到输出的时间	—	18	30		图 5
t _w	移位时钟宽度	10	20	—		图 1
t _w	存储时钟宽度	10	20	—		图 2
t _w	复位时间宽度	15	25	—		图 4
t _{SU}	存储的数据建立时间	16	25	—		图 3
t _{SU}	移位的数据建立时间	16	25	—		图 2
t _h	数据保持时间	3	12	—		图 3
t _{rem}	复位到移位时钟的时间	10	17	—		图 4
f _{max}	最大时钟频率 RCK 或 SCK	30	52	—	MHz	图 1、2

十、交流特性波形图



MLB195

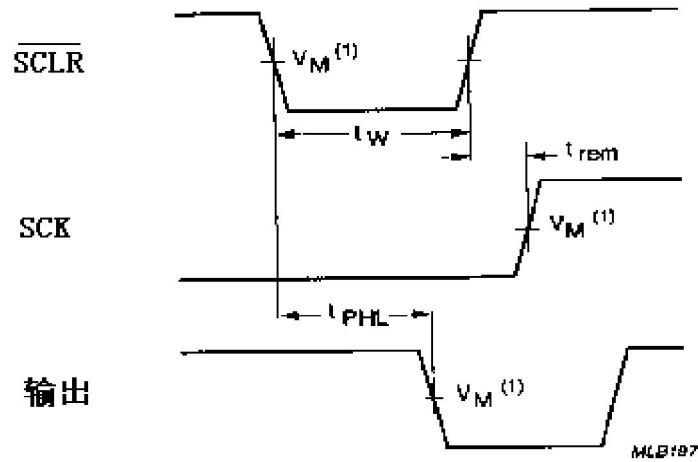


图4

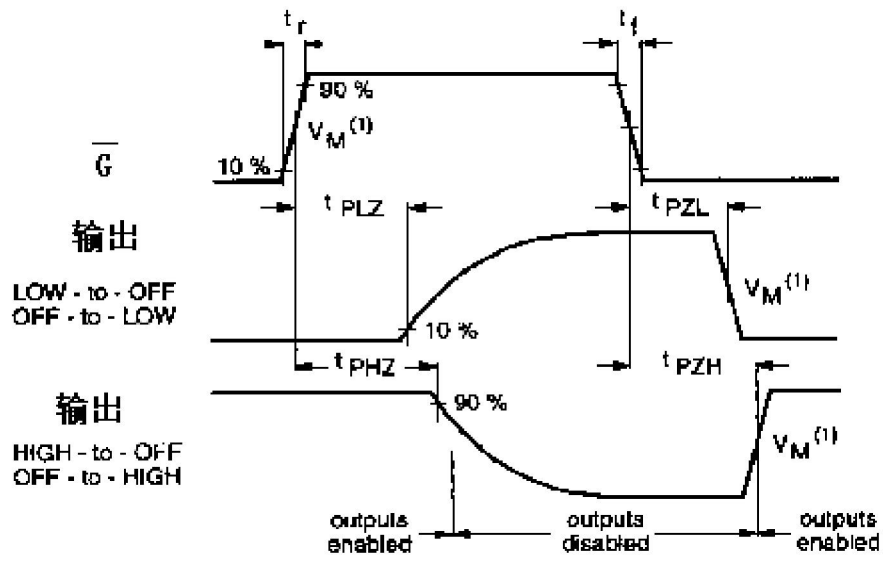
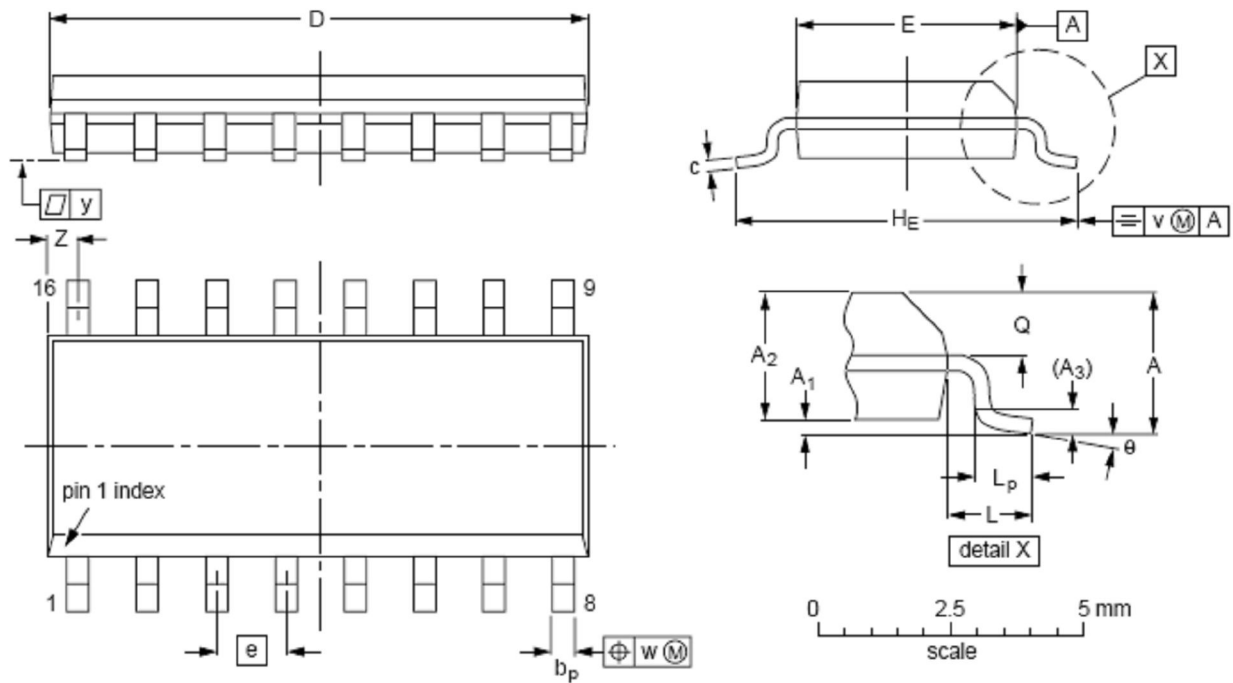


图5

十一、封装示意图



DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A _{max.}	A ₁	A ₂	A ₃	b _p	c	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	e	H _E	L	L _p	Q	v	w	y	Z ⁽¹⁾	e
mm	1.75	0.25 0.10	1.45 1.25	0.25	0.49 0.36	0.25 0.19	10.0 9.8	4.0 3.8	1.27	6.2 5.8	1.05	1.0 0.4	0.7 0.6	0.25	0.25	0.1	0.7 0.3	8° 0°
inches	0.059	0.010 0.004	0.057 0.049	0.01	0.019 0.014	0.0100 0.0075	0.39 0.38	0.16 0.15	0.050	0.244 0.228	0.041	0.039 0.016	0.028 0.020	0.01	0.01	0.004	0.028 0.012	